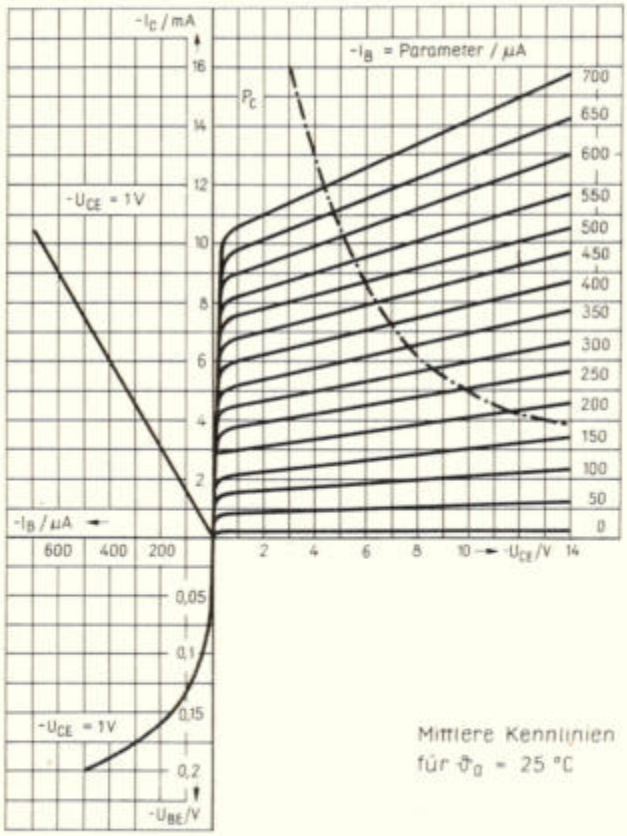
Germanium-pnp-Legierungstransistor **GC 112**

Der NF-Transistor GC 112 ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor in dem Gehäuse ≈ TO 18.
Der Einsatz ist vornehmlich in NF-Stufen für Steuer- und Regelungszwecke mit größerer Sperrspannung.

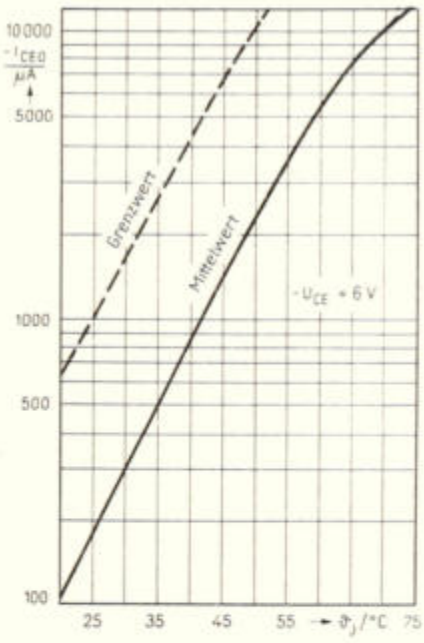
Statische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25\,°C - 5$ grd)

Kollektorrestströme $-I_{CBO} = 1{,}5 \leq 15\,\mu A$ bei $-U_{CB} = 6\,V$
$-I_{CEO} = 105 \leq 600\,\mu A$ bei $-U_{CE} = 6\,V$



Mittlere Kennlinien für $\vartheta_0 = 25\,°C$

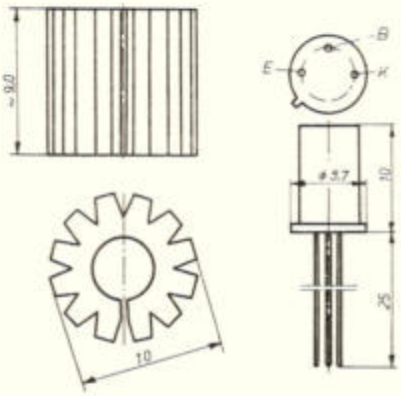
Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung



Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

Abmessungen

Kühlkörper wird auf freitragenden Transistor gestreift.
Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW



Masse 0,8 g

Kollektorstrom

$I_C \leq 10$ mA (bei $U_{CE}(t) = U_{=} + \tilde{U}_{\sim}(t)$

$U_{=} = 66 \pm 2$ V

$\tilde{U}_{\sim} = 90 \pm 5\ V_{eff}$

Stromverstärkungsfaktor in Emitterschaltung

$h_{21e} = 11 \ldots 35$ bei $-U_{CE} = 6$ V, $-J_C = 2$ mA

Wärmewiderstand $R_{th} \leq 0{,}43 \frac{grd}{mW}$

Grenzwerte (für $\vartheta_a = 45\,°C$)

$-U_{EBO} = 10$ V

$-U_{CES} \geq 80$ V (bei $R_{BE} = 0\,\Omega$)

$-I_C = 125$ mA

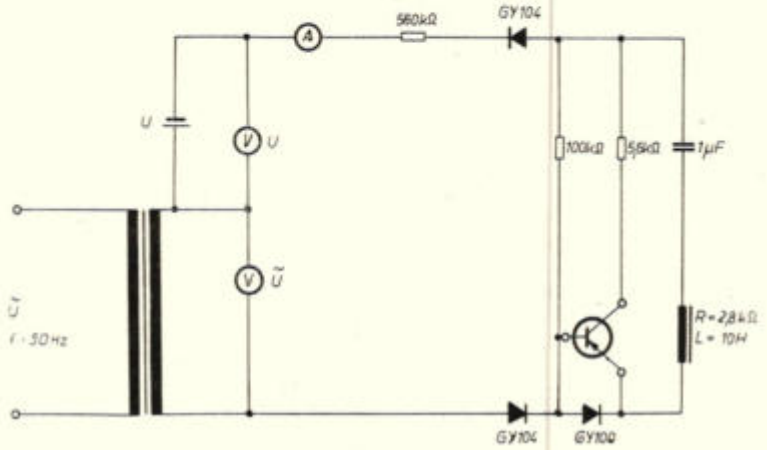
$-I_B = 25$ mA

$I_E = 150$ mA

$\vartheta_j = 75\,°C$

$\vartheta_a = 65\,°C$

Anwendung



Meßschaltung

Bestellbezeichnung für einen Transistor: **Transistor GC 112**